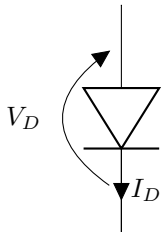


DIODO



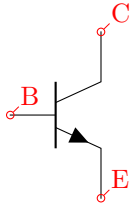
OFF

$$\begin{cases} I_D = 0 \\ V_D < V_\gamma \end{cases}$$

ON

$$\begin{cases} V_D = V_\gamma \\ I_D > 0 \end{cases}$$

BJT



- OFF

$$I_B = I_C = I_E = 0 \quad \text{per } V_{BE} < V_\gamma$$

- AD

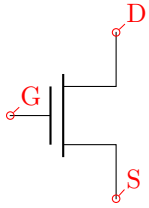
$$\begin{aligned} V_{BE} &= V_\gamma & \text{per } V_{CE} > V_{CE_{SAT}} \\ I_C &= \beta_F I_B & I_B > 0 \end{aligned}$$

- SAT

$$\begin{aligned} V_{BE} &= V_\gamma \\ V_{CE} &= V_{CE_{SAT}} & I_C < \beta_F I_B \end{aligned}$$

MOSFET N-MOS

Trasferisce uno 0 forte: $V_L = 0V$



- OFF

$$I_{DS} = 0 \quad \text{per } V_{GS} < V_{Tn}$$

- SATURAZIONE

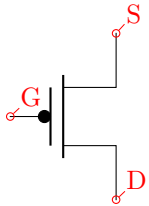
$$I_D = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_{Tn})^2 \quad \text{per } \begin{cases} V_{DS} \geq V_{GS} - V_{Tn} \\ V_{GS} \geq V_{Tn} \end{cases}$$

- LINEARITÀ

$$I_D = \beta \left((V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right) \quad \text{per } \begin{cases} V_{DS} < V_{GS} - V_{Tn} \\ V_{GS} \geq V_{Tn} \end{cases}$$

MOSFET P-MOS

Trasferisce 1 forte $V_H = V_{CC}$



- OFF

$$I_{SD} = 0 \quad \text{per } V_{SG} < |V_{TP}|$$

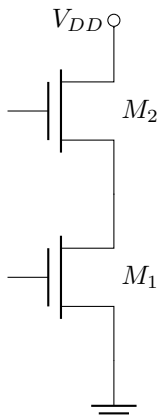
- SATURAZIONE:

$$I_{SD} = \frac{\beta}{2} (V_{SG} - |V_{TP}|)^2 \quad \text{per } \begin{cases} V_{SD} \geq V_{SG} - |V_{TP}| \\ V_{SG} > |V_{TP}| \end{cases}$$

- LINEARITÀ:

$$I_{SD} = \beta \left((V_{SG} - |V_{TP}|) V_{SD} - \frac{V_{SD}^2}{2} \right) \quad \text{per } \begin{cases} V_{SD} < V_{SG} - |V_{TP}| \\ V_{SG} \geq |V_{TP}| \end{cases}$$

N-mos in serie



$$\beta_{eq} = \frac{\beta_1 \beta_2}{\beta_1 + \beta_2}$$

In parallelo $\beta_{eq} = \beta_1 + \beta_2$. Per applicare queste formule le tensioni ai capi dei transistori devono essere le stesse.

La connessione in parallelo alla rete di pull-down è interpretabile come una somma logica (or) ed una connessione in serie come un prodotto (and). L'espressione finale è negata. Nella risoluzione applicata con questa formula, quando la rete CMOS è spenta, l'uscita V_u è a 0.

Calcolo del tempo di propagazione

Quando viene calcolato il tempo di propagazione, controlla per quali condizioni di V_u variano le regioni di funzionamento del transistorio.